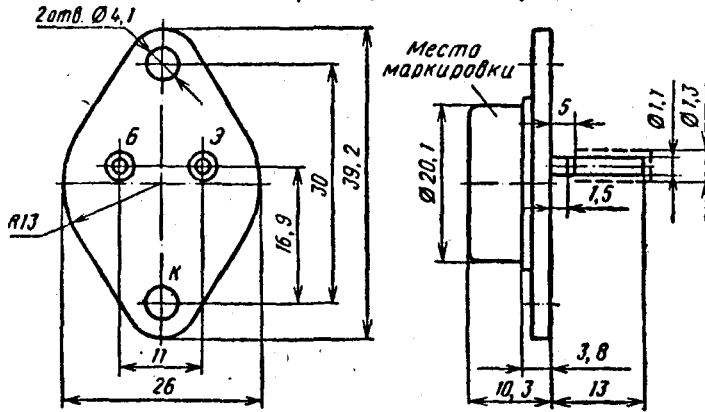


2Т826 (А, Б, В), КТ826 (А, Б, В)

Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры *n-p-n* переключабельные. Предназначены для применения в преобразователях постоянного напряжения, высоковольтных стабилизаторах, переключающих устройствах. Корпус металлический со стеклянными изоляторами и жесткими выводами.

Масса транзистора не более 20 г.

2Т826 (А-В), КТ826 (А-В)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи в схеме ОЭ при $U_{кв} = 10$ В, $I_{к} = 0,1$ А:

$T_{н} = +25^{\circ}\text{C}$	10...120
$T_{н} = T_{н, макс}$	5...300
$T_{н} = -60^{\circ}\text{C}$	5...120

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $U_{кв} = 15$ В, $I_{к} = 0,1$ А, $f = 1$ МГц, не менее:

2Т826В, КТ826В	6
2Т826А, 2Т826Б; КТ826А, КТ826Б	4

Граничное напряжение при $I_{к} = 100$ мА, $L = 40$ мГн, не менее:

2Т826А, 2Т826В, КТ826А, КТ826В	500 В
2Т826Б, КТ826Б	600 В

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_{к} = 0,5$ А, $I_{в} = 0,2$ А, не более

2Т826А, 2Т826В, КТ826А, КТ826В	2,5 В
--------------------------------	-------

Напряжение насыщения база — эмиттер при $I_{к} = 0,5$ А, $I_{в} = 0,2$ А, не более

2Т826А, 2Т826В, КТ826А, КТ826В	2 В
--------------------------------	-----

Время спада при $U_{кв} = 500$ В, $U_{вв} = 5$ В, $I_{к} = 0,5$ А, $I_{в} = 0,2$ А, не более:

2Т826А, КТ826А	1,5 мкс
2Т826Б, КТ826Б	0,7 мкс

Обратный ток коллектор — эмиттер при $R_{сэ} = 10$ Ом, не более:

$T_{н} = +25^{\circ}\text{C}$, $U_{кв} = 700$ В	2 мА
$T_{н} = T_{н, макс}$, $U_{кв} = 300$ В	5 мА
$T_{н} = -60^{\circ}\text{C}$, $U_{кв} = 500$ В	4 мА

Обратный ток эмиттера при $U_{вв} = 5$ В, не более

2Т826А, 2Т826В, КТ826А, КТ826В	3 мА
--------------------------------	------

Емкость коллекторного перехода при $U_{кв} = 100$ В, $f = 1$ МГц, не более

2Т826А, 2Т826В, КТ826А, КТ826В	25* пФ
2Т826Б, КТ826Б	20* пФ

Емкость эмиттерного перехода при $U_{вв} = 5$ В, $f = 1$ МГц, не более

2Т826А, 2Т826В, КТ826А, КТ826В	250* пФ
--------------------------------	---------

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при $R_{сэ} \leq 10$ Ом, $T_{н} = -60...+75^{\circ}\text{C}$ 700 В

Импульсное напряжение коллектор — эмиттер при $R_{сэ} \leq 10$ Ом, $t_u \leq 20$ мс, $Q \geq 50$: 700 В

$t_{\phi} \geq 0,2$ мкс (скорость нарастания фронта не более 3,5 В/нс), $T_{н} = -60...+75^{\circ}\text{C}$ 700 В

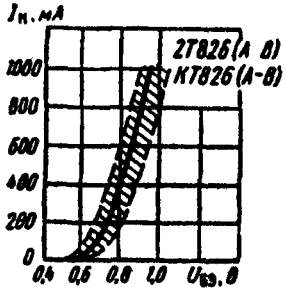
$t_{\phi} \geq 1,5$ мкс (скорость нарастания фронта не более 0,66 В/нс), $T_{\kappa} = +25^{\circ}\text{C}$	1000 В
Постоянный и импульсный ток коллектора	1 А
Постоянный и импульсный ток базы	0,75 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора ¹ при $T_{\kappa} = -60...+50^{\circ}\text{C}$	15 Вт
Температура p-n перехода	150 ^o С
Температура окружающей среды:	
2Т826А—2Т826В	-60 ^o С... $T_{\kappa} = +125^{\circ}\text{C}$
КТ826А—КТ826В	-60 ^o С... $T_{\kappa} = +100^{\circ}\text{C}$

¹ При $T_{\kappa} > +50^{\circ}\text{C}$ $P_{\kappa, \text{ макс}}$ рассчитывается по формуле $P_{\kappa, \text{ макс}} = (150 - T_{\kappa}) / R_{T(n-\kappa)}$, где $R_{T(n-\kappa)}$ — определяется из области максимальных режимов.

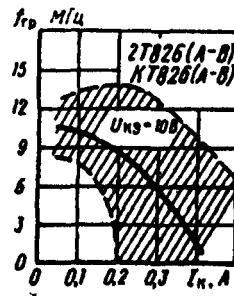
При $T_{\kappa} > +75^{\circ}\text{C}$ постоянное и импульсное напряжение коллектор — эмиттер снижаются линейно до 300 В.

Пайка выводов транзисторов допускается не ближе 5 мм от основания корпуса при температуре не более +250^oС в течение не более 3 с.

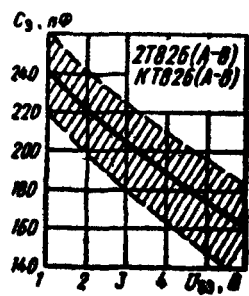
При конструировании аппаратуры следует учитывать возможность самовозбуждения транзисторов за счет паразитных связей.



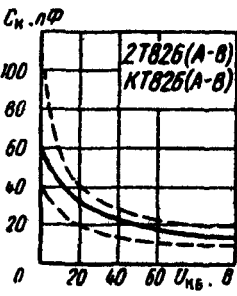
Зона возможных положений зависимости тока коллектора от напряжения база — эмиттер



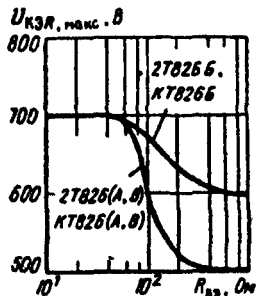
Зона возможных положений зависимости граничной частоты от тока коллектора



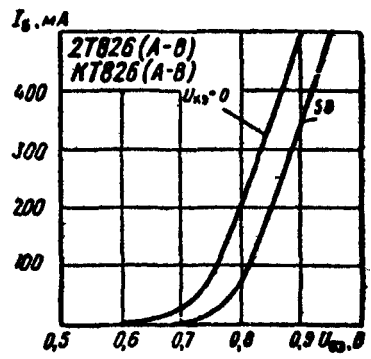
Зона возможных положений зависимости емкости эмиттерного перехода от напряжения база — эмиттер



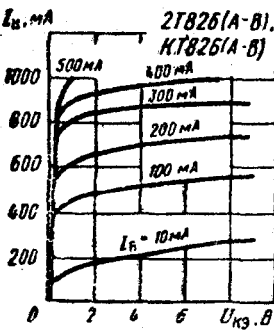
Зона возможных положений зависимости емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор — база



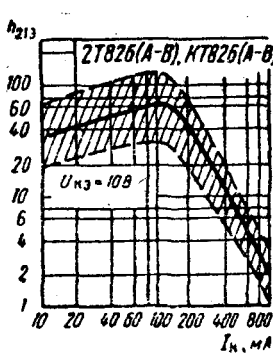
Зависимость максимально допустимого постоянного напряжения коллектор — эмиттер от сопротивления база — эмиттер



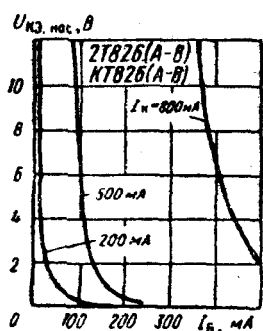
Входные характеристики



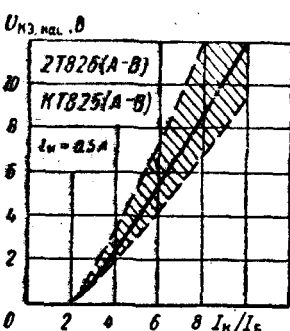
Входные характеристики



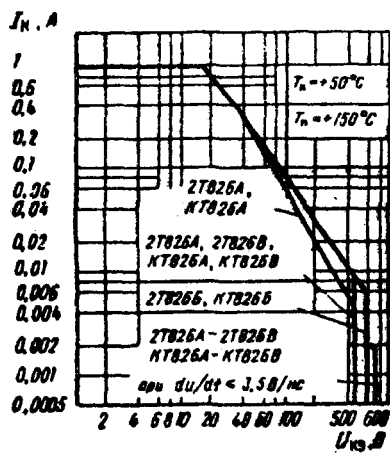
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



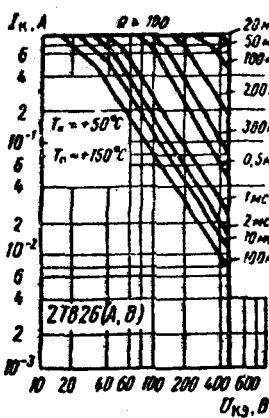
Зависимости напряжения насыщения коллектор — эмиттер от тока базы



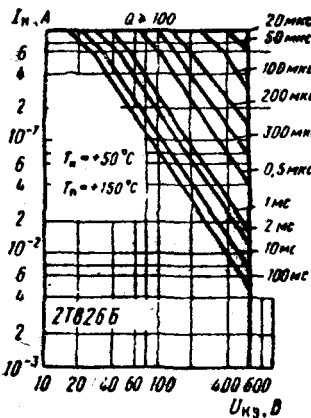
Зона возможных положений зависимости напряжения насыщения коллектор — эмиттер от отношения тока коллектора и базы



Области максимальных режимов



Области максимальных режимов



Области максимальных режимов

Зависимости импульсного теплового сопротивления переход — корпус от длительности импульса

